

13003A1.18三极管 可订做

产品名称	13003A1.18三极管 可订做
公司名称	佛山市合芯半导体有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:华晶 型号:HS13003A1.18
公司地址	中国广东佛山市顺德区容桂梯云路21号
联系电话	86-075533160599 13312932316

产品详情

h13003a 为合芯半导体专为手机充电器生产的高反压功率三极管，此款三极管价格实惠、电流性能基本满足智能手机充电使用。features:high voltage capability

high speed switching

wide soa

applications:flourscent lamp

electronic ballast

electronic transformer

limmiting values($t_j=25$ unless otherwise stated)

parameter	symbol	value	unit
collector-base voltage	v _{cb0}	700	v
collector-emitter voltage	v _{ce0}	490	v
emitter-base voltage	v _{eb0}	9	v
collector current	i _c	1.0	a
total power dissipation	p _c	0.8	w
storage temperature	t _{stg}	-65~150	
junction temperature	t _j	150	

electrical characteristics ($t_j=25$ unless otherwise stated)

parameter	symbol	test conditions	min
collector-base breakdown voltage	bvcb0	$i_c=0.5\text{ma}, i_e=0$	700
collector-emitter breakdown voltage	bvceo	$i_c=10\text{ma}, i_b=0$	490
emitter-base breakdown voltage	bvebo	$i_e=1\text{ma}, i_c=0$	9
collector-base cutoff current	icbo	$v_{cb}=600\text{v}, i_e=0$	
collector- emittercutoff current	iceo	$v_{ce}=400\text{v}, i_b=0$	
emitter-base cutoff current	iebo	$v_{eb}=9\text{v}, i_c=0$	
dc current gain	hfe(1)	$v_{ce}=5\text{v}, i_c=200\text{ma}$	10
collector-emitter saturation voltage	vce(sat)	$i_c=200\text{ma}, i_b=40\text{ma}$	
base-emitter saturation voltage	vbe(sat)	$i_c=200\text{ma}, i_b=40\text{ma}$	
storage time	ts	$v_{ce}=10\text{v}, i_c=100\text{ma}$	2.0
falling time	tf	$f=1\text{mhz}$	5

本产品的应用范围是高反压，品牌是华晶，型号是HS13003A1.18，材料是硅(Si)，封装形式是TO-126